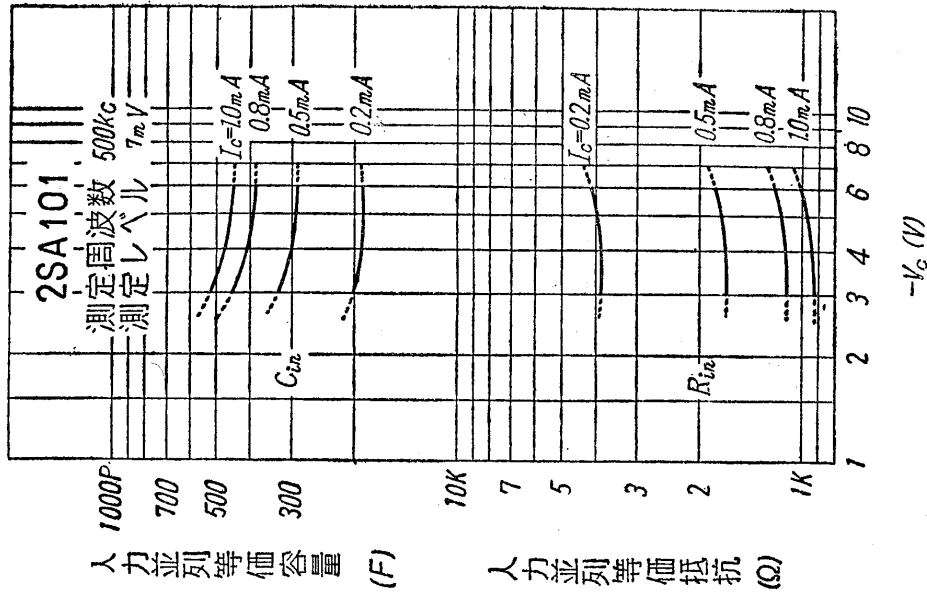
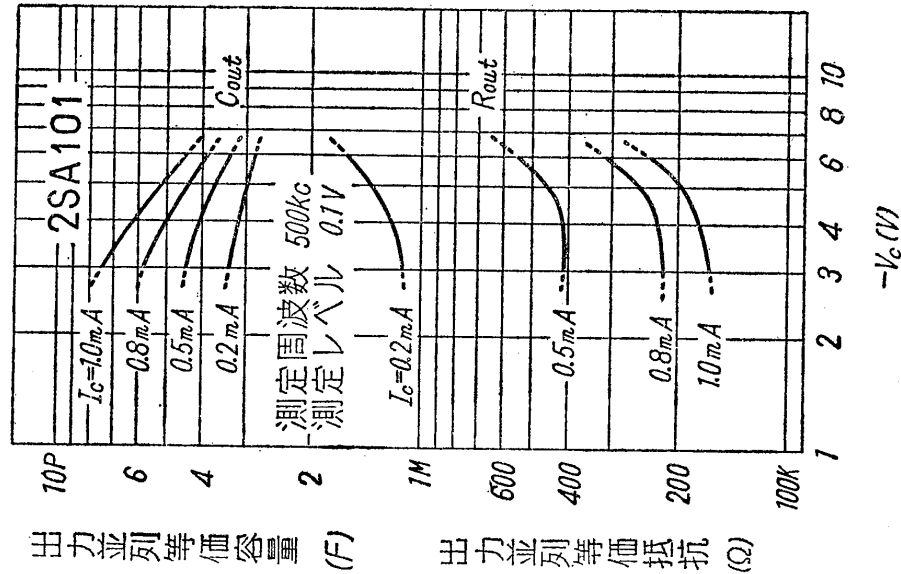


〔第5図〕 入力インピーダンスとコレクタ電圧との関係

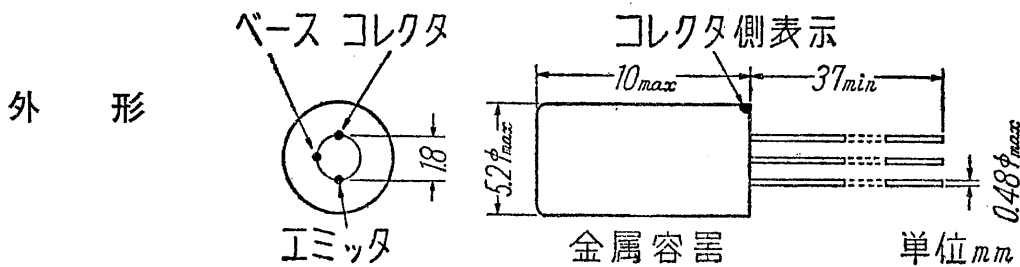


〔第6図〕 出力インピーダンスとコレクタ電圧との関係



# 2SA102 (MC102) — PNPドリフト型ゲルマニウムトランジスタ

2SA102 は 2SA101 と同様に完全金属封止のPNPドリフト型トランジスタで、短波帯の発振、混合回路および455kcの中間周波増幅回路に使用され好結果が得られています。



2SA102(MC102)

最大定格

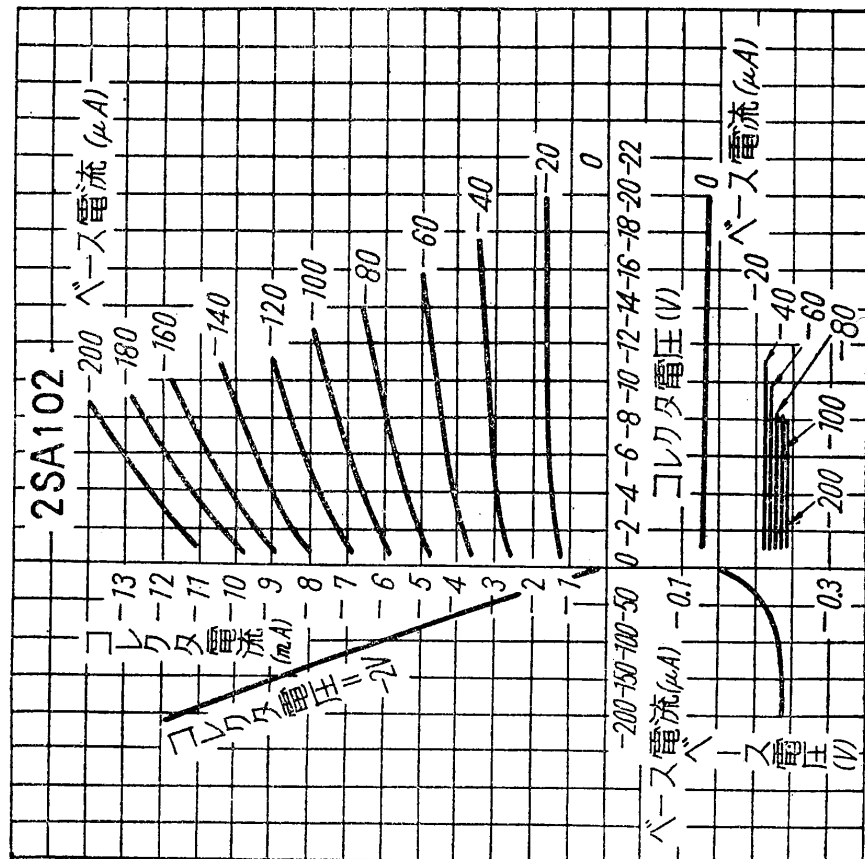
保存温度 $T_{stg}$	.....	-55 ~ +85	°C
ジャンクション温度 $T_j$	.....	75	°C
コレクタ・ベース電圧 $-V_{CBM}$	.....	最大 40	V
エミッタ・ベース電圧 $-V_{EBM}$	.....	最大 0.5	V
コレクタ電流 $-I_C$	.....	最大 10	mA
エミッタ電流 $I_E$	.....	最大 10	mA
コレクタ損失 $P_C$	.....	最大 60	mW

特性 (周囲温度 25°C において)

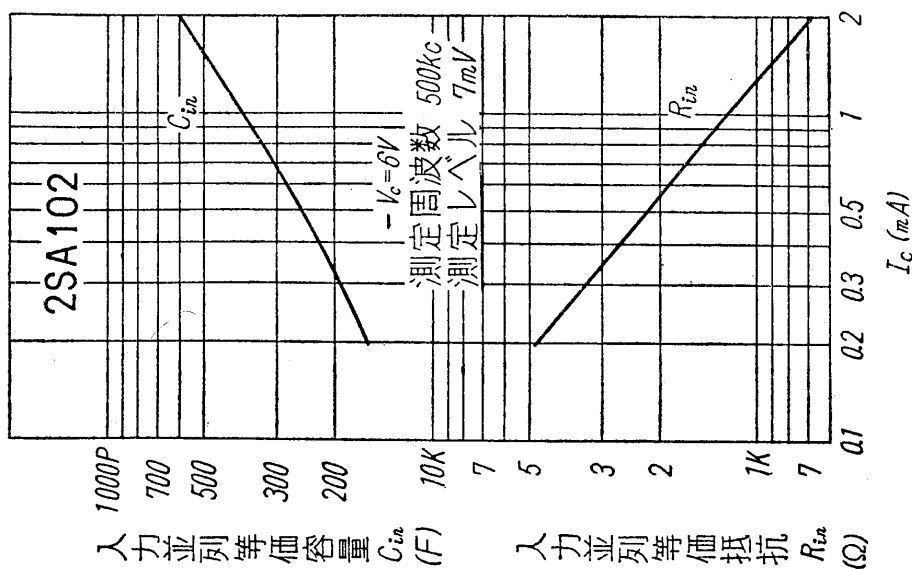
共通ベース接続

	最小	平均	最大
コレクタ遮断電流 $-I_{CBO}$ ( $-V_{CB}=10V, I_E=0$ )	.....		15 $\mu A$
$\alpha$ 遮断周波数 $f_{ab}$ ( $-V_{CB}=6V, I_E=1mA$ )	20	25	Mc
閉路順方向電流増幅率 $h_{fe}$ ( $-V_{CE}=6V, I_E=1mA$ )	15	40	250
コレクタ容量 $C_{b'c}$ ( $-V_{CB}=6V, I_E=1mA$ )	.....	1.7	5.0 pF
ベース拡がり抵抗 $r_{bb'}$ ( $-V_{CB}=6V, I_E=1mA$ )	.....	40	70 $\Omega$
開放出力アドミッタレス $h_{ob}$ ( $-V_{CB}=6V, I_E=1mA$ )	.....		1.5 $\mu V$

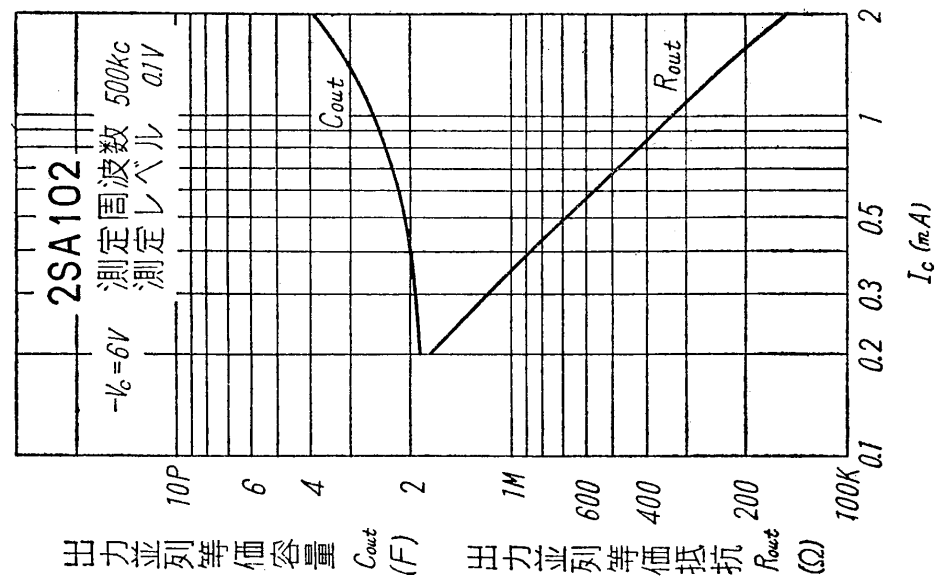
〔第1図〕ドリフト・トランジスタ  
の代表的な特性曲線  
(エミッタ接地)



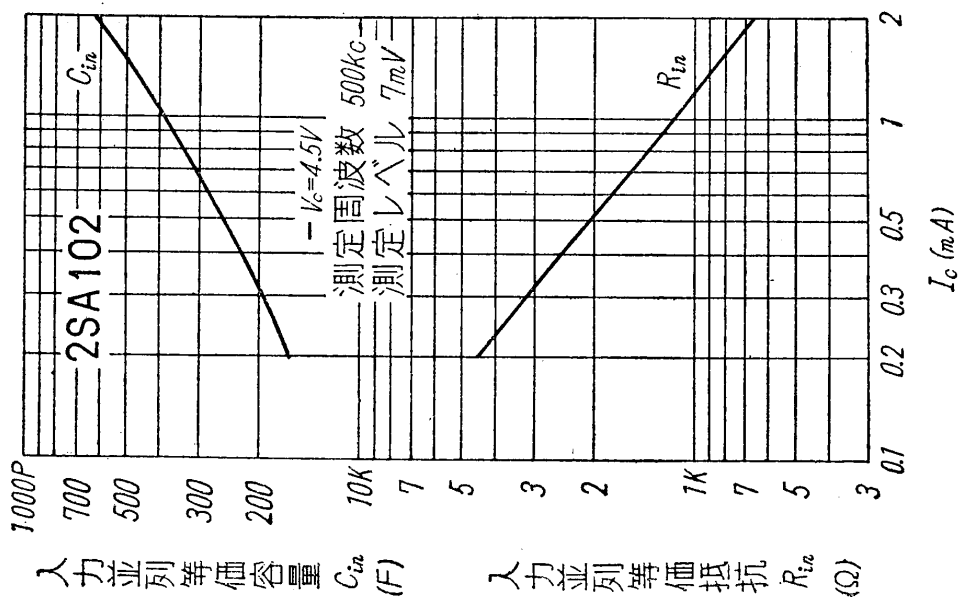
〔第2図(a)〕コレクタ電流と入力インピーダンスとの関係  
( $-V_{CE}=6V$ )



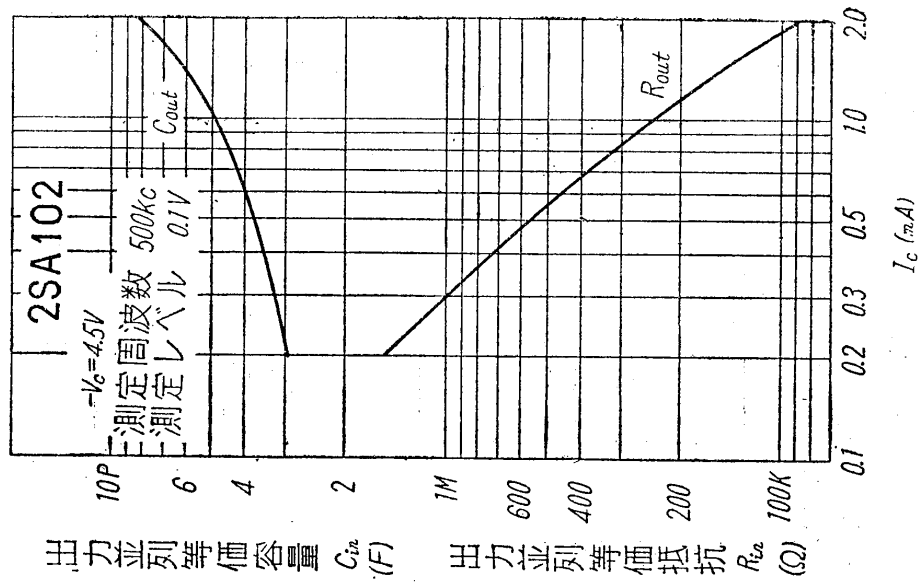
〔第2図(b)〕コレクタ電流と出力インピーダンスとの関係  
( $-V_{CE}=6V$ )



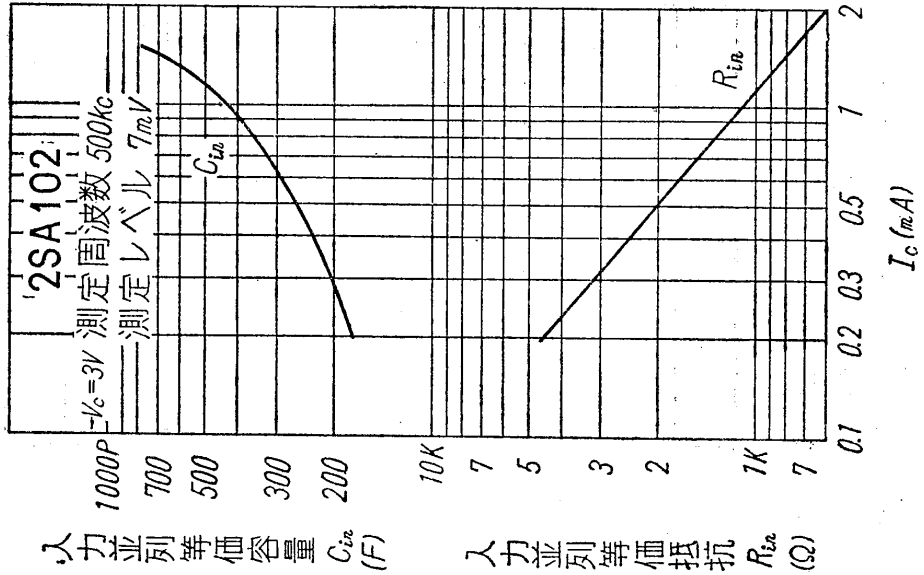
〔第3図(a)〕コレクタ電流と入力インピーダンスとの関係  
( $-V_{CE}=4.5V$ )



〔第3図(b)〕 コレクタ電流と出  
カインピーダンスとの関係  
( $-V_{CE}=4.5V$ )



〔第4図(a)〕 コレクタ電流と入  
カインピーダンスとの関係  
( $-V_{CE}=3V$ )



〔第4図(b)〕 コレクタ電流と出  
カインピーダンスとの関係  
( $-V_{CE}=3V$ )

